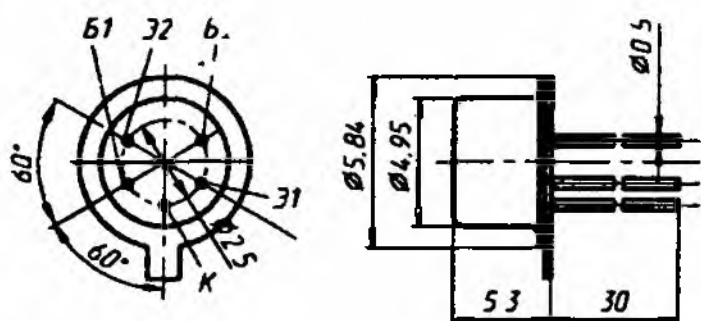


2Т118А, 2Т118Б, 2Т118В, КТ118А, КТ118Б, КТ118В

2Т118(А-В) КТ118(А-В)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные двухэмиттерные структуры $p-n-p$ переключаемые. Предназначены для применения в модуляторах. Выпускаются в металlostеклянном корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на боковой поверхности корпуса.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

Электрические параметры

Падение напряжения на открытом ключе:

при $I_b = 0,5$ мА, $T = +25$ °С, не более:

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б 0,2 мВ

2Т118В, КТ118В 0,15 мВ

$T = -60$ °С:

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б 0,4 мВ

2Т118В, КТ118В 0,3 мВ

$T = +125$ °С 0,6 мВ

при $I_b = 1,5$ мА, $T = +25$ °С:

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б 0,2 мВ

2Т118В, КТ118В 0,15 мВ

$T = +125$ °С 1,2 мВ

$T = -60$ °С 0,18 мВ

Сопротивление открытого ключа:

при $I_b = 2$ мА, $I_c = 2$ мА, $T = +25$ °С, не более:

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б 100 Ом

2Т118В, КТ118В 120 Ом

$T = +125$ °С:

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б 60 Ом

2Т118В, КТ118В 70 Ом

при $I_b = 20$ мА, $I_c = 40$ мА, $T = +25$ °С:

2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б 20 Ом

2Т118В, КТ118В 40 Ом

$T = +125$ °С:

$T = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б	40 Ом
2Т118В, КТ118В	80 Ом
$T = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2Т118А, 2Т118Б, КТ118А, КТ118Б	50 Ом
2Т118В, КТ118В	80 Ом
Ток закрытого ключа при $U_{зз} = 30\text{ В}$ для 2Т118А, КТ118А и $U_{зз} = 15\text{ В}$ для 2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, КТ118В, не более:	
$T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,1 мкА
$T = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	5 мкА
$T = -60\text{ }^{\circ}\text{C}$	0,1 мкА
Напряжение на управляющих переходах при $T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $I_b = 20\text{ мА}$, не более	
	1 В
Асимметрия сопротивления открытого ключа при $T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $I_b = 40\text{ мА}$, $I_z = 20\text{ мА}$, не более	
	20%
Обратный ток коллектор—база 1, коллек- тор—база 2 при $T = +25\text{ }^{\circ}\text{C}$ и $U_k = 15\text{ В}$, не более	
	0,1 мкА
Время выключения транзисторной структу- ры при $R_H = 1\text{ кОм}$, $I_b = 20\text{ мА}$, $U_k = 5\text{ В}$, не более	
	500 нс

Предельные эксплуатационные данные

Напряжение управления между коллектором и базой транзисторной структуры при $R_{кб} \leq 10\text{ кОм}$ и $T = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	
	15 В
Постоянное напряжение на закрытом ключе между эмиттерами при $U_{упр} = 0$ и $T = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2Т118А, КТ118А	30 В
2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, КТ118В	15 В
Постоянное напряжение эмиттер—база тран- зисторной структуры при $T = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$:	
2Т118А, КТ118А	31 В
2Т118Б, 2Т118В, КТ118Б, КТ118В	16 В
Постоянный ток коллектора при $T = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	
	50 мА
Постоянный ток каждого эмиттера при $T = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	
	25 мА
Постоянный ток каждой базы при $T = -60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$	
	25 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллек- тора:	

при $T = -60...+100\text{ }^{\circ}\text{C}$	100 мВт
при $T = +125\text{ }^{\circ}\text{C}$	62,5 мВт
Тепловое сопротивление переход—окружающая среда	0,4 $^{\circ}\text{C}/\text{мВт}$
Температура окружающей среды	$-60...+125\text{ }^{\circ}\text{C}$

Изгиб выводов допускается не ближе 5 мм от корпуса транзистора. Допускается одноразовый изгиб вывода на расстоянии 3 мм и радиусом не менее 0,5 мм.

Пайка выводов допускается не ближе 3 мм от корпуса транзистора при температуре не выше $+250\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение времени не более 9 с. Пайка производится паяльником мощностью не более 60 Вт и напряжением 6...12 В.